

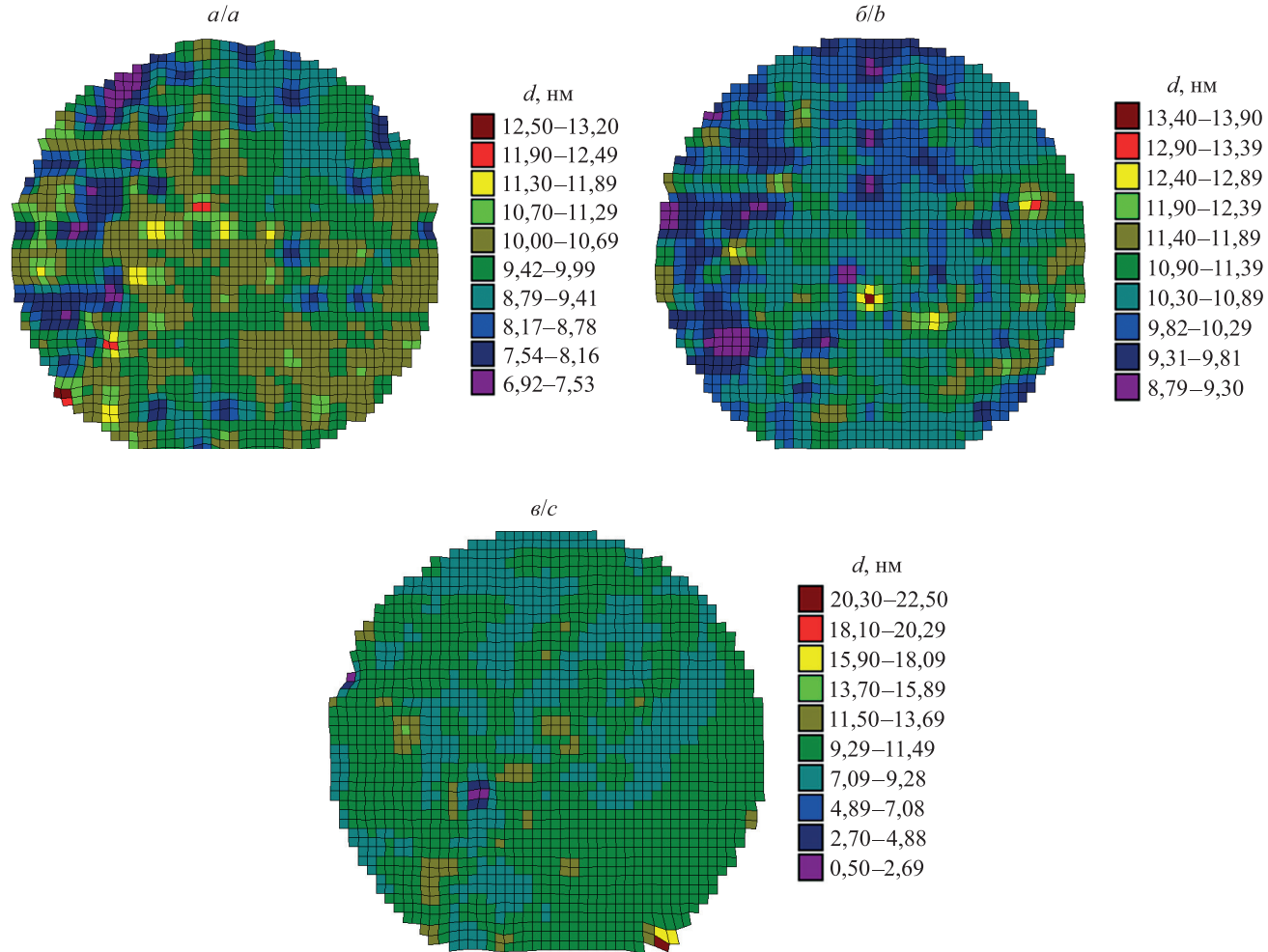


Рис. 1. Топограммы распределения толщин: a – термического SiO₂, полученного при 900 °С

в течение 30 мин ($\langle d \rangle = 9,7$ nm); δ , ϵ – оксидов, полученных методом БТО в ходе фотонных обработок длительностью 12 с при максимальной температуре 1250 °С (δ – двухстадийный процесс в атмосфере O₂ ($\langle d \rangle = 10,5$ nm); ϵ – трехстадийный процесс с двумя обработками в атмосфере O₂ и третьей обработкой в формовочном газе ($\langle d \rangle = 9,7$ nm))

Fig. 1. Topograms of the thickness distribution: a – thermal SiO₂ obtained at 900 °С for 30 min ($\langle d \rangle = 9.7$ nm); b , c – oxides obtained by the RTP method by photonic treatments for 12 s

and a maximum temperature of 1250 °С (b – two-stage process in O₂ atmosphere ($\langle d \rangle = 10.5$ nm); c – three-stage process with two treatments in an O₂ atmosphere, the third treatment in a forming gas ($\langle d \rangle = 9.7$ nm))